## Аномальная электронная эмиссия из монокристаллов ниобата и танталата лития

## © А.Т. Козаков, В.В. Колесников, А.В. Никольский, В.П. Сахненко

Научно-исследовательский институт физики при Ростовском-на-Дону государственном университете, 344702 Ростов-на-Дону, Россия

## (Поступила в Редакцию 11 ноября 1996 г.)

Обнаружена и исследована аномальная эмиссия электронов с поверхности  $(10\bar{1}4)$  LiNbO<sub>3</sub> и LiTaO<sub>3</sub>, возбужденная мягким рентгеновским излучением. Установлено отсутствие аномальной эмиссии с грани  $(10\bar{1}0)$  этих же монокристаллов. Экспериментальные результаты подтверждают теоретические выводы о том, что аномальная эмиссия обусловлена наличием максимума в распределении потенциала в приповерхностном слое. Рассчитана зависимость времени жизни  $\tau$  эффекта аномальной эмиссии от диэлектрической постоянной  $\varepsilon$  сегнетоэлектрика.

В работе [1] сообщалось об обнаруженном нами эффекте аномальной эмиссии медленных электронов из поляризованного монокристалла магнониобата свинца. Обычно в спектре медленных электронов, возбужденных мягким рентгеновским излучением, в области кинетических энергий  $\approx 0-20 \text{ eV}$  регистрируется одиночный пик, форма которого отражает особенности электронного строения твердого тела и адсорбатного покрытия, а также коэффициента прозрачности и других характеристик поверхности [2–5].

Ввиду не вполне традиционного характера получаемой информации для этого направления исследований в спектроскопии твердого тела в [2-5] была принята специальная аббревиатура РЭЭМЭ (рентгеновская эмиссия электронов малых энергий). При исследовании спектров РЭЭМЭ с поверхности кристалла PbMg<sub>1/3</sub>Nb<sub>2/3</sub>O (в которую предварительно инжектировали электронный заряд) в области более высоких кинетических энергий регистрировалась дополнительная структура, происхождение которой связано с аномалиями рельефа потенциала в поверхностном слое сегнетоэлектрика до глубин  $\simeq 10^3 \text{ Å}$  [1]. В связи с тем что форма регистрируемого электронного спектра определяется электрофизическими свойствами поверхностного слоя, а не только известными закономерностями фотоэлектронной эмиссии [6], эта эмиссия была названа нами аномальной [1].

При любом срезе монокристалла магнониобата свинца имеется нормальная к поверхности составляющая вектора поляризации, что не позволило проверить некоторые следствия теории аномальной эмиссии, развитой в [1]. Ниобат и танталат лития относятся к одноосным сегнетоэлектрикам [7], и для них возможно исследование эффекта аномальной эмиссии с граней, обладающих различными поляризационными характеристиками. В соответствии с [1] направление вектора поляризации должно радикальным образом влиять на интенсивность и форму спектра электронной эмиссии.

Были исследованы спектры электронной эмиссии с двух граней монокристаллов ниобата и танталата лития: с грани (1010), в которой находится ось поляризации, а также с грани (1014), к которой ось поляризации наклонена под углом 37°55′, т.е. имеется нормальная к поверхности компонента вектора поляризации.

Отрицательный заряд инжектировался в поверхностный слой с помощью накладных электродов из нержавеющей стали при постоянном напряжении 800 V в течение от 10 до 30 min при толщине монокристалла 0.5 mm.

Измерения потенциала по компенсационному методу [8] показали, что монокристаллы ниобата и танталата лития всегда удавалось заполяризовать независимо от направления оси поляризации относительно граней, к которым прикладывались электроды. Характер изменения электретного потенциала со временем для ниобата и танталата лития согласуется с релаксационными зависимостями, которые обсуждались в [7]. Будем называть отрицательной поверхность монокристалла, в которую инжектирован электронный заряд, и положительной противоположную сторону.

Аномальная эмиссия наблюдалась с отрицательной поверхности (1014) обоих монокристаллов (ниобата и танталата лития) после их поляризации, в то время как с поверхности (1010) аномальная эмиссия отсутствовала.

На рис. 1 (спектр 1) приведена форма спектра аномальной эмиссии с отрицательной поверхности свежеполяризованного монокристалла LiNbO<sub>3</sub> (плоскость 1014). Остальные два спектра (2 и 3) получены для той же поверхности, но с интервалом, соответственно равным 1 и 2 суток. Как уже упоминалось выше, а также в соответствии с [1] детали спектра определяются особенностями распределения потенциала по глубине поляризованного образца. Согласно [1,9], рельеф потенциала  $\varphi(z)$  в поверхностном слое может быть приближенно рассчитан на основе формы I(E) экспериментального спектра по формуле

$$z/l = -\ln\left\{1 - \int_{-\infty}^{\varphi(z)} dE I(E)/I_s\right\} \cos\theta; \qquad (1)$$

в которой  $I_s$  — интегральная интенсивность спектра,  $\theta$  — угол между нормалью к образцу и направлением на щель энергоанализатора. Строго говоря, метод, предложенный



**Рис. 1.** Аномальная эмиссия в спектрах РЭЭМЭ с грани (1014) LiNbO<sub>3</sub>. *1* — свежеполяризованный образец, *2* — через 24 h, *3* — через 48 h.

в [9], применим лишь к узким линиям рентгеноэлектронных спектров, однако для качественных оценок его можно применить и к спектрам аномальной эмиссии [1].

В качестве примера на рис. 2 приведен рассчитанный по спектру I (рис. 1) потенциал  $\varphi(z)$ . Видно, что "полочкам" в распределении потенциала соответствуют максимумы в распределении электронного спектра; чем меньше наклон "полочки" к оси z и больше ее длина, тем более узким и интенсивным является электронный пик. Протяженность спектра пропорциональна высоте максимума в распределении потенциала.

Электронный спектр, согласно [1], пропорционален первой производной от потенциала. В связи со сказанным выше и тем, что  $\partial^2 \varphi / \partial z^2 \sim \rho$  ( $\rho$  — суммарная плотность связанного и свободного заряда), первая производная экспериментального спектра может быть использована для качественных выводов как о характере распределения плотности заряда в поверхностном слое, так и ее кинетике.

Из совместного анализа рис. 1 и 3 (рассчитанная из спектров *1–3* (рис. 1) форма потенциала) можно видеть, как релаксирует потенциал в поляризованном

образце ниобата лития (плоскость  $(10\bar{1}4)$ ). Со временем общая ширина спектра увеличивается, в нем появляется дополнительная структура, а общая интенсивность электронного спектра уменьшается. С точки зрения формы потенциала это означает увеличение наклона "полочек" к оси *z*, уменьшение их длины и появление новых "полочек" (кривые *1–3* на рис. 1).

Отсутствие электронной эмиссии с поляризованной поверхности ( $10\overline{1}0$ ) при наличии электретной разности потенциалов служит экспериментальным подтверждением выводов теории [1] о том, что аномальная эмиссия обусловлена сложным рельефом потенциала в поверхностном слое, а именно наличием в этой области ускоряющей электроны напряженности поля и максимума в распределении потенциала. Согласно [1], этот эффект существует лишь вдоль полярной оси, которая для LiNbO<sub>3</sub> и LiTaO<sub>3</sub> параллельна плоскости ( $10\overline{1}0$ ). Это означает, что при внесении электретного заряда в поверхность ( $10\overline{1}0$ ) распределение потенциала в приповерхностной области будет качественно таким же, как и в линейном диэлектрике, монотонно спадая по глубине.



**Рис. 2.** Распределение потенциала  $\varphi$  по глубине поляризованного образца z (штриховая линия) и спектр РЭЭМЭ I(E) (сплошная линия). Масштабы по оси абсцисс для  $E_{kin}$  и  $\varphi$  совпадают. Глубина z/l в относительных единицах (l — длина свободного пробега электрона) в логарифмическом масштабе.



**Рис. 3.** Распределение потенциала  $\varphi(z)$ , рассчитанное по спектрам *1–3* (рис. 1). Нумерация на рисунке совпадает с нумерацией спектров рис. 1.

Иная картина наблюдается при внесении электретного заряда в поверхность (1014) ниобата и тантала лития: из-за наличия вертикальной поверхности составляющей вектора поляризации в этих объектах, так же как и в магнониобате свинца [1], возможен эффект аномальной эмиссии.

Согласно [1], физическая природа эффекта аномальной электронной эмиссии связана с наличием характерной для сегнетоэлектриков N-образной особенности в уравнении состояния вещества, т.е. в зависимости поля от поляризации E(P), и с обусловленной этим спецификой экранирования поля  $E_0(z)$  электретного заряда. Отклик твердого тела на него приводит, как в любом диэлектрике, к появлению экранирующего (деполяри-



**Рис. 4.** Теоретическая зависимость времени жизни  $\tau$  эффекта аномальной эмиссии от диэлектрической постоянной  $\varepsilon$  сегнетоэлектрика. Точки — эксперимент. *I* — LiTaO<sub>3</sub>, *2* — LiNbO<sub>3</sub>, *3* — PbMg<sub>1/3</sub>Nb<sub>2/3</sub>O<sub>3</sub>.

зующего) поля, в одномерном случае равного  $-4\pi P$ . В нормальной системе направление результирующего поля  $E = E_0 - 4\pi P$  совпадает с "внешним" полем  $E_0$ . Качественно иная ситуация имеет место в области сегнетоэлектрической неустойчивости: здесь деполяризующее поле, будучи также направленным противоположно Е<sub>0</sub>, превосходит его по абсолютной величине, приводя к изменению направления результирующего поля Е в поверхностном слое электрета. Если поверхностная плотность электретного заряда  $\sigma$  превосходит по величине спонтанную поляризацию P<sub>s</sub>, то, как показано в [1], это приводит к появлению максимума в зависимости  $\varphi(z)$  в поверхностном слое и эффекту аномальной электронной эмиссии. Обозначив характерную скорость ухода электронов с глубоких ловушек, отнесенную к единице поверхности, через  $j_0$ , можно оценить время auсуществования указанного эффекта выражением

$$\tau = \bar{\sigma} / j_0, \tag{2}$$

в котором  $\bar{\sigma} = \sigma - P_s$ .

Параметр  $j_0$  можно выразить через энергию активации  $\Delta$ , определяемую энергией связи центров локализации электретного заряда,

$$1/j_0 = s_0 e^{\Delta/T}, \quad s_0 = \text{const.}$$
 (3)

С помощью выражений (2), (3) можно оценить характер зависимости времени жизни  $\tau$  от величины диэлектрической постоянной  $\varepsilon$  сегнетоэлектрика при фиксированной электретной разности потенциалов  $U_e$  (обычно  $U_e \cong 100-200 \,\mathrm{V}$ ).

Напряженность поля  $E_0 = U_e/L$  (L — толщина образца) в объеме электрета [1]

$$\frac{4\pi\bar{\sigma}}{\varepsilon} = E_0. \tag{4}$$

От величины  $\varepsilon$  зависит также энергия  $\Delta$  в выражении (3). Определение вида  $\Delta(\varepsilon)$  для глубоких примесных состояний в полупроводниках и диэлектриках

является самостоятельной и достаточно сложной задачей, как правило связанной с громоздкими численными расчетами [10,11]. Сложность проблемы связана с тем, что характерный радиус локализации волновых функций этих состояний часто оказывается сравнимым с межатомными расстояниями, делая не вполне адекватным представление формы потенциала в их окрестности через макроскопический параметр  $\varepsilon$ . Однако для целей качественной физической оценки вида зависимости  $\tau(\varepsilon)$  ограничимся простой моделью водородоподобного иона, в которой [10]

$$\Delta(\varepsilon) = \Delta_0 / \varepsilon^2.$$
 (5)

Параметр  $\Delta_0 \cong 14 \, \text{eV}$ .

С учетом (2)–(4) это позволяет для  $\tau(\varepsilon)$  получить простое аналитическое выражение

$$\tau(\varepsilon) = \frac{E_0 s_0}{4\pi} e^{\alpha/\varepsilon^2} \varepsilon, \tag{6}$$

где  $\alpha = \Delta_0/T$ .

Оно имеет минимум при  $\varepsilon = \varepsilon_0 \equiv \sqrt{2\alpha}$  (величина  $\varepsilon_0 \cong 30$ ). Вид зависимости  $\tau(\varepsilon)$ , определяемый (6), показан на рис. 4, где  $\tau_0$  — значение  $\tau$  при  $\varepsilon = \varepsilon_0$ .

Наблюдаемые времена релаксации эффекта аномальной электронной эмиссии, составляющие для магнониобата свинца около месяца, для LiNbO<sub>3</sub> — дни, для LiTaO<sub>3</sub> — десяток часов, также приведены на рис. 4 (принято  $\tau_0 = 3$  h). Соответствующие экспериментальные значения  $\varepsilon$  у этих объектов  $\cong 10^4$  (PbMg<sub>1/3</sub>Nb<sub>2/3</sub>O<sub>3</sub>),  $\cong 100$  (LiNbO<sub>3</sub>) и  $\cong 50$  (LiTaO<sub>3</sub>) [8,12]. Из этих оценок видно неплохое согласие теории и эксперимента. Из них, в частности, следует, что слева от минимума время жизни  $\tau$  должно быть чувствительным к особенностям электронной структуры ловушек, справа от него рост  $\tau(\varepsilon)$  в основном связан с ростом поверхностного заряда  $\bar{\sigma}$  при фиксированной электретной разности потенциалов.

Таким образом можно сделать следующие выводы.

1) Обнаружена аномальная эмиссия с поляризованной поверхности (1014) LiNbO<sub>3</sub> и LiTaO<sub>3</sub>, с поверхности (1010) она отсутствует.

2) Основной причиной этого различия является ориентация полярной оси относительно граней, в которые инжектируется электретный заряд, т.е. наличие или отсутствие нормальной к поверхности составляющей вектора поляризации.

3) Спектр аномальной эмиссии отражает особенности распределения заряда и рельефа потенциала в поверхностном слое сегнетоэлектрика-электрета.

## Список литературы

- А.Т. Козаков, В.В. Колесников, В.П. Сахненко, А.В. Никольский, И.В. Новиков, Е.М. Панченко, Е.С. Емельянов. ФТТ 38, 8, 2524 (1996).
- [2] А.Т. Козаков, В.В. Колесников, А.В. Никольский, В.П. Сахненко. ФТТ 36, 2, 317 (1994).

- [3] А.Т. Козаков, В.В. Колесников, А.В. Никольский, В.П. Сахненко. ФММ 77, *6*, 109 (1994).
- [4] А.Т. Козаков, В.В. Колесников, А.В. Никольский, В.П. Сахненко. ФММ 77, *6*, 118 (1994).
- [5] А.Т. Козаков, В.В. Колесников, А.В. Никольский, В.П. Сахненко. Изв. вузов. Сев.-кавказ. регион. Спец. вып., 93 (1994).
- [6] В.И. Нефедов, В.Т. Черепин. Физические методы исследования поверхности твердого тела. М. (1983). 296 с.
- [7] Ю.С. Кузьминов. Электрооптический и нелинейно оптический кристалл ниобата лития. М. (1987). 264 с.
- [8] А.Н. Губкин. Электреты. М. (1978). 190 с.
- [9] А.Т. Козаков, В.В. Колесников, А.В. Никольский. Физическая природа аномалий в рентгеноэлектронных спектрах и электрофизические свойства каменных углей. Препринт. Изд-во сев.-кавказ. науч. центра высшей шк., Ростов н/Д (1993). 46 с.
- [10] А.М. Стоунхэм. Теория дефектов в твердых телах. (1978).
  Т. 2. 855 с.
- [11] В.В. Колесников, В.Ф. Волков, Е.В. Положенцев, Ю.А. Люблинский. Металлофизика 7, *1*, 30 (1985).
- [12] Ю.С. Кузьминов. Сегнетоэлектрические кристаллы для управления лазерным излучением. М. (1982). 400 с.